
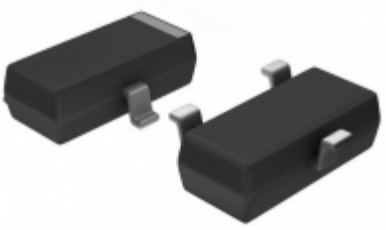
	<p><b>SI2315BDS-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI2315BDS-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 3A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2315BDS-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 159241 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2315BDS-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 3A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	159241 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 3.85A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	715pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI2315BDS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2315BDS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2315BDS-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2315BDS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2314EDS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3.77A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2315BDS</b> KEXIN SI2315BDS KEXIN</p>	 <p><b>SI2315DS</b> 89K SI2315DS 89K</p>	 <p><b>SI2314EDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3.77A SOT23-3</p>
 <p><b>SI2315BDS-T1</b> VISHAY VISHAY 1253+</p>	 <p><b>SI2314EDS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3.77A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2315BDS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 3A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2315DS-T1</b> VISHAY SI2315DS-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⊗ SI2312BDS        | ↔ SI2312BDS-T1-E3  | ➔ SI2312BDS-T1-E3  | D SI2312BDS-T1-GE3 | ➔ SI2312BDS-T1-GE3 |
| ⊣ SI2312CDS-T1-E3  | ⊗ SI2312CDS-T1-GE3 | D SI2312CDS-T1-GE3 | ➔ SI2312DS         | ➔ SI2312DS-T1      |
| ⊗ SI2312DS-T1-E3   | ⊣ SI2312DS-T1-GE3  | ⊗ SI2313DS         | ↔ SI2313DS-T1-E3   | ➔ SI2313DS-T1-GE3  |
| D SI2314DS         | ⊗ SI2314DS-T1-E3   | ⊣ SI2314DS-T1-GE3  | ⊗ SI2314EDS        | ➔ SI2314EDS-T1-E3  |
| ➔ SI2314EDS-T1-E3  | ↔ SI2314EDS-T1-GE3 | ⊗ SI2314EDS-T1-GE3 | ⊣ SI2315BDS        | ➔ SI2315BDS-T1-E3  |
| ↔ SI2315BDS-T1-GE3 | ➔ SI2315BDS-T1-GE3 | D SI2315DS         | ⊗ SI2315DS-T1      | ⊣ SI2315DS-T1-E3   |
| ⊗ SI2315DS-T1-GE3  | D SI2316-DS        | ➔ SI2316BDS-T1-E3  | ↔ SI2316BDS-T1-E3  | ➔ SI2316BDS-T1-GE3 |
| ⊣ SI2316BDS-T1-GE3 | ⊗ SI2316DS         | ↔ SI2316DS-T1-E3   | ➔ SI2316DS-T1-E3   | ➔ SI2316DS-T1-GE3  |
| ⊗ SI2316DS-T1-GE3  | ⊣ SI2317DS         | ⊗ SI2317DS-T1-E3   | D SI2318ADS-T1-GE3 | ➔ SI2318BDS-T1-E3  |
| ↔ SI2318BDS-T1-GE3 | ⊗ SI2318CDS-T1-E3  | ⊣ SI2318CDS-T1-GE3 | ⊗ SI2318CDS-T1-GE3 | ➔ SI2318DS         |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited